

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
младшего научного сотрудника
в лаборатории «Фотоэлектрических преобразователей»
Вакансия VAC_PTI_25007

Тематика исследований

Газофазная (МОС-гидридная) эпитаксия гетероструктур на основе твёрдых растворов $A^{III}B^V$ для создания полупроводниковых приборов

Трудовая деятельность

Проведение научных исследований и разработок в области физики высокоэффективных фотоэлектрических преобразователей солнечного, лазерного, радиолуминесцентного излучения, фотоэнергосистем на их основе в составе коллектива лаборатории (<http://pvlab.ioffe.ru>) включая:

- Разработка технологий газофазной эпитаксии твёрдых растворов $A^{III}B^V$ (тройных, четверных);
- Проектирование гетероструктур на основе твёрдых растворов $A^{III}B^V$ для создания фотоэлектрических преобразователей;
- Исследование фотовольтаических характеристик гетероструктур полупроводников $A^{III}B^V$;
- Подготовка статей для публикаций в ведущих мировых и отечественных журналах, а также представление полученных результатов на международных и российских конференциях;
- Подготовка и подача материалов для регистрации результатов интеллектуальной деятельности;
- Руководство и обучение студентов фундаментальным и прикладным навыкам разработки и исследования высокоэффективных фотоэлектрических преобразователей.

Конкретные обязанности будут определяться исходя из квалификации соискателя.

Требования к претенденту

- Высшее профессиональное образование, степень магистра по направлению «Электроника и нанoeлектроника»;
- Знания в области физики полупроводников;
- Опыт научной работы по специальности не менее 2 лет;
- Владение английским языком;
- Наличие публикаций в журналах, индексируемых Scopus, WoS или РИНЦ не менее 2 за последние 5 лет;
- Опыт участия в грантах (Минобрнауки, РФФИ) в качестве руководителя и/или исполнителя;
- Знания в области металл-органической газофазной эпитаксии твёрдых растворов $A^{III}B^V$;
- Навыки работы с установкой AIXTRON 200/4;
- Знания и навыки в области компьютерного моделирования полупроводниковых приборов (Silvaco TCAD, Sentaurus TCAD и т.п.);

Конкретные обязанности будут определяться исходя из квалификации соискателя.

- ☐ ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 31600 руб.
- ☐ СТАВКА: 0.1
- ☐ Срок трудового договора – до 31.12.2027

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы

- ☐ копии документов о высшем профессиональном образовании;
- ☐ копии документов о присуждении учёной степени, присвоении учёного звания (при наличии);
- ☐ сведения о научной работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса, список публикаций;

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26, учёному секретарю ФТИ им. А.Ф. Иоффе М.И. Патрову, телефон для справок: (812) 297 22 45.